
	<h2>SI3434DV-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI3434DV-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 4.6A 6-TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3434DV-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 36578 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI3434DV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 4.6A 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	36578 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 4.6A (Ta) 1.14W (Ta) Surface Mount 6-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.14W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	34 mOhm @ 6.1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	600mV @ 1mA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI3434DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3434DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3434DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3434DV-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3434DV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 4.6A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3435DV-T1-GE3</b> VISHAY SI3435DV-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p><b>SI3434DV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 4.6A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3435DV-T1</b> VISHAY SI3435DV-T1 VISHAY</p>
 <p><b>SI3434DV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 4.6A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3434DV-T1</b> VISHAY SI3434DV-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI3437DV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 150V 1.4A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3437DV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 150V 1.4A 6-TSOP</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI3424DV-T1-GE3	 SI3424DV-T1-E3	 SI3425DV	 SI3429EDV-T1-GE3	 SI3429EDV-T1-GE3
 SI3430DV-T1	 SI3430DV-T1-GE3	 SI3430DV-T1-GE3	 SI3433BDV-T1	 SI3433BDV-T1-E3
 SI3433BDV-T1-E3	 SI3433BDV-T1-GE3	 SI3433BDV-T1-GE3	 SI3433CDV-T1-E3	 SI3433CDV-T1-E3
 SI3433CDV-T1-GE3	 SI3433CDV-T1-GE3	 SI3433DN	 SI3433DV-T1	 SI3433DV-T1-E
 SI3433DV-T1-E3	 SI3433DV-T1-GE3	 SI3434DV-T1	 SI3434DV-T1-E3	 SI3434DV-T1-E3
 SI3434DV-T1-GE3	 SI3435DV-T1	 SI3435DV-T1-E3	 SI3435DV-T1-GE3	 SI3437DV-T1-E3
 SI3437DV-T1-E3	 SI3437DV-T1-GE3	 SI3437DV-T1-GE3	 SI3438DV-T1-E3	 SI3438DV-T1-E3
 SI3438DV-T1-GE3	 SI3438DV-T1-GE3	 SI3440ADV-T1-GE3	 SI3440ADV-T1-GE3	 SI3440DV-T1-E3
 SI3440DV-T1-E3	 SI3440DV-T1-GE3	 SI3440DV-T1-GE3	 SI3441BDV	 SI3441BDV-T1
 SI3441BDV-T1-E3	 SI3441BDV-T1-E3	 SI3441BDV-T1-GE3	 SI3441BDV-T1-GE3	 SI3441DV

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited